

Applicants: **Mamoru NAKASUJI, et al.**  
Serial No.: **09/891,511**

Docket No.: **010819**  
Page 4

**REMARKS**

Claims 16, 25, 30, 44-49, 54 and 59 have been amended. No new claims have been added. Claims 1-60 are pending.

A marked-up version of the changes made to the claims is enclosed herewith as "VERSION WITH MARKINGS TO SHOW CHANGES MADE."

The above amendments to the claims have been made to correct the multiple dependency of the above-listed claims. It is respectfully submitted that purpose of the amendments incorporated herein are to better place the application in condition for examination.

In the event that any additional fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,

ARMSTRONG, WESTERMAN, HATTORI  
McLELAND & NAUGHTON, LLP



William G. Kratz, Jr.  
Attorney for Applicants  
Reg. No. 22,631

Enclosures: Version With Markings to Show Changes Made  
Amendment Transmittal (w/ appropriate fees)

Attorney Docket No.: **010819**  
1725 K Street, N.W.  
Suite 1000  
Washington, D.C. 20006  
Tel: (202) 659-2930  
WGK/sdj

Q:\FLOATERS\WGK\010819 Preliminary Amendment

**VERSION WITH MARKINGS TO SHOW CHANGES MADE**  
**U.S. Serial No. 09/891,511**

**IN THE CLAIMS:**

Claims 16, 25, 30, 44-49, 54 and 59 have been amended as follows:

16. (Amended) A method of manufacturing a device comprising the steps of:  
detecting defects on a wafer using an inspection apparatus according to any one of claims 1 to ~~15~~ 5 in the middle of a process or subsequent to the process.

25. (Amended) A defect inspection apparatus using the E x B separator defined by any of claims 21 to ~~24~~ 23, in which:  
either one of said first charged particle beam or said second charged particle beam is a primary sample to be inspected, and the other is a secondary charged particle beam generated from said sample by the irradiation of said primary charged particle beam.

30. (Amended) A method for manufacturing a device using an inspection apparatus defined by any one of claims 26 to ~~29~~ or 27, in which a pattern inspection is performed in the device manufacturing processes.

44. (Amended) A charged particle beam apparatus in accordance with either of claim 41 to ~~43~~ or 42, in which said dividers are arranged in two locations in the proximity of the charged particle beam irradiating location and the proximity of the hydrostatic bearing.

1. **Содержание**  
 2. **Введение**  
 3. **Глава I. Общие положения**  
 4. **Глава II. Организация и структура**  
 5. **Глава III. Основные задачи и функции**  
 6. **Глава IV. Методы и средства**  
 7. **Глава V. Результаты и выводы**  
 8. **Заключение**  
 9. **Список литературы**  
 10. **Приложения**  
 11. **Справочные материалы**  
 12. **Дополнительные материалы**  
 13. **Информационные материалы**  
 14. **Детские материалы**  
 15. **Детские материалы**  
 16. **Детские материалы**  
 17. **Детские материалы**  
 18. **Детские материалы**  
 19. **Детские материалы**  
 20. **Детские материалы**  
 21. **Детские материалы**  
 22. **Детские материалы**  
 23. **Детские материалы**  
 24. **Детские материалы**  
 25. **Детские материалы**  
 26. **Детские материалы**  
 27. **Детские материалы**  
 28. **Детские материалы**  
 29. **Детские материалы**  
 30. **Детские материалы**  
 31. **Детские материалы**  
 32. **Детские материалы**  
 33. **Детские материалы**  
 34. **Детские материалы**  
 35. **Детские материалы**  
 36. **Детские материалы**  
 37. **Детские материалы**  
 38. **Детские материалы**  
 39. **Детские материалы**  
 40. **Детские материалы**  
 41. **Детские материалы**  
 42. **Детские материалы**  
 43. **Детские материалы**  
 44. **Детские материалы**  
 45. **Детские материалы**  
 46. **Детские материалы**  
 47. **Детские материалы**  
 48. **Детские материалы**  
 49. **Детские материалы**  
 50. **Детские материалы**  
 51. **Детские материалы**  
 52. **Детские материалы**  
 53. **Детские материалы**  
 54. **Детские материалы**  
 55. **Детские материалы**  
 56. **Детские материалы**  
 57. **Детские материалы**  
 58. **Детские материалы**  
 59. **Детские материалы**  
 60. **Детские материалы**  
 61. **Детские материалы**  
 62. **Детские материалы**  
 63. **Детские материалы**  
 64. **Детские материалы**  
 65. **Детские материалы**  
 66. **Детские материалы**  
 67. **Детские материалы**  
 68. **Детские материалы**  
 69. **Детские материалы**  
 70. **Детские материалы**  
 71. **Детские материалы**  
 72. **Детские материалы**  
 73. **Детские материалы**  
 74. **Детские материалы**  
 75. **Детские материалы**  
 76. **Детские материалы**  
 77. **Детские материалы**  
 78. **Детские материалы**  
 79. **Детские материалы**  
 80. **Детские материалы**  
 81. **Детские материалы**  
 82. **Детские материалы**  
 83. **Детские материалы**  
 84. **Детские материалы**  
 85. **Детские материалы**  
 86. **Детские материалы**  
 87. **Детские материалы**  
 88. **Детские материалы**  
 89. **Детские материалы**  
 90. **Детские материалы**  
 91. **Детские материалы**  
 92. **Детские материалы**  
 93. **Детские материалы**  
 94. **Детские материалы**  
 95. **Детские материалы**  
 96. **Детские материалы**  
 97. **Детские материалы**  
 98. **Детские материалы**  
 99. **Детские материалы**  
 100. **Детские материалы**

59. (Amended) A semiconductor manufacturing method for manufacturing a semiconductor by using the apparatus in accordance with either of claims 55 to 58 or 56.